
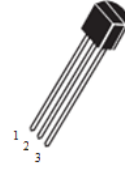


NPN通用晶体管

 Lead(Pb)-Free

TO-92

1.发射极
2.基
3.收集



绝对最大额定值 (TA = 25°C)

等级	符号	价值	单位
集电极 - 发射极电压	VCEO	25	VDC
集电极 - 基极电压	VCBO	40	VDC
发射极 - 基极电压	VEBO	5.0	VDC
集电极电流	IC	500	MADC
器件总耗散T $A=25^{\circ}C$	PD	0.625	W
结温	Tj	150	°C
存储温度	TSTG	-55到+150	°C

电气特性

特征	符号	民	最大	单位
集电极 - 发射极击穿电压 (IC = 0.1 MADC , IB = 0)	V (BR) CEO	25	-	VDC
集电极 - 基极击穿电压 (IC = 100 μ Adc , IE = 0)	V (BR) CBO	40	-	VDC
发射极 - 基极击穿电压 (IE = 100 μ Adc , IC = 0)	V (BR) EBO	5.0	-	VDC
集电极截止电流 (VCE = 20 伏 , IB = 0)	ICE0	-	0.1	μ Adc
集电极截止电流 (VCB = 40 VDC , IE = 0)	ICBO	-	0.1	μ Adc
发射极截止电流 (VEB = 3.0VDC , IC = 0)	IEBO	-	0.1	μ Adc

S8050 **WEITRON****电气特性**

(TA=25°C除非另有说明) (Continued)

特征	符号	民	典型值	最大	单位
----	----	---	-----	----	----

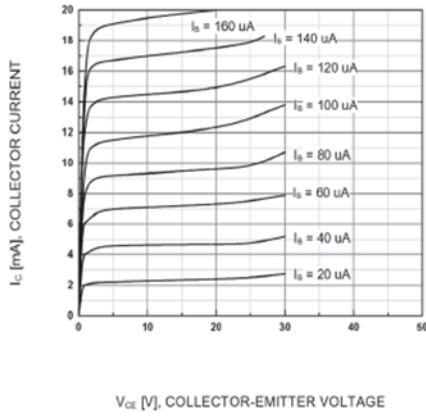
基本特征

直流电流增益 (IC=50 ADC, VCE=1.0 V 直流)	的hFB)	85	-	300	-
直流电流增益 (IC=500 MADC, VCE=1.0 V 直流)	的hFE)	50	-	-	-
集电极-发射极饱和电压 (IC=500 ADC, IB=50 MADC)	VCE (SAT)	-	-	0.6	VDC
基极饱和电压 (IC=500 MADC, IB=50 MADC)	VBE (SAT)	-	-	1.2	VDC
电流增益带宽积 (IC=20 MADC, VCE=6.0伏, F=30MHz)	fT	150	-	-	兆赫

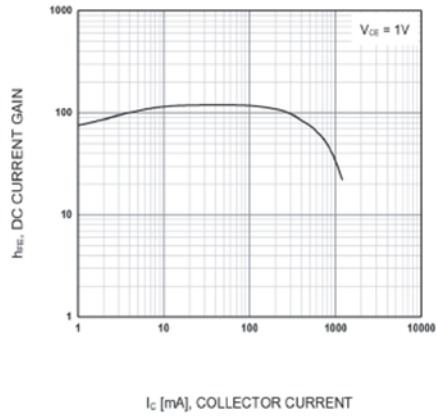
HFE分类 (1)

秩	B	C	D
范围	85-160	120-200	160-300

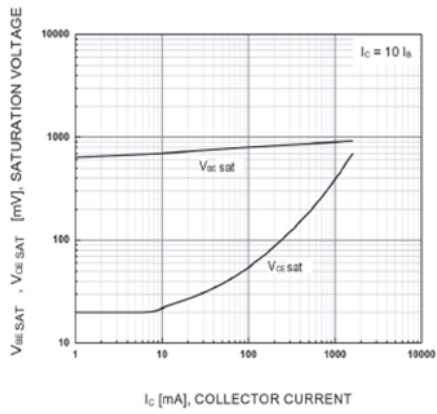
Typical Characteristics



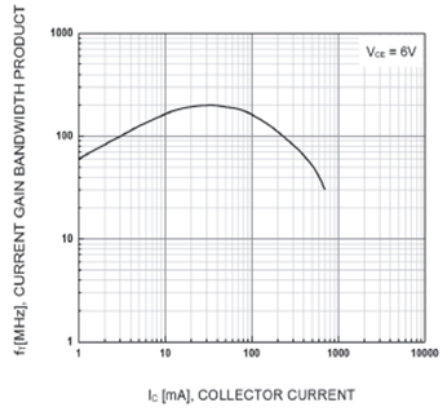
Static Characteristic



DC current Gain



**Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage**



Current Gain Bandwidth Product